

Способ включает размещение исходного стержня в камере выращивания, вакуумирование камеры выращивания, расплавление исходного стержня и дозированную подачу легирующего элемента соплом к зоне расплава. В процессе вакуумирования производят дополнительное осушивание камеры выращивания и технологической оснастки, а дозированную подачу осуществляют в центр зоны расплава с расстояния, равного 1,1-1,5 радиуса выращиваемого монокристалла.